

(12) 特許協力条約に基づいて公開された国際出願

(19) 世界知的所有権機関
国際事務局

(43) 国際公開日
2022年9月29日(29.09.2022)



(10) 国際公開番号

WO 2022/202029 A1

(51) 国際特許分類:
B32B 27/00 (2006.01) H01L 21/60 (2006.01)
H01L 21/02 (2006.01) B32B 7/06 (2019.01)
H01L 21/304 (2006.01)

(21) 国際出願番号: PCT/JP2022/006804

(22) 国際出願日: 2022年2月21日(21.02.2022)

(25) 国際出願の言語: 日本語

(26) 国際公開の言語: 日本語

(30) 優先権データ:
特願 2021-053121 2021年3月26日(26.03.2021) JP

(71) 出願人: 日産化学株式会社(NISSAN CHEMICAL CORPORATION) [JP/JP]; 〒1036119 東京都中央区日本橋二丁目5番1号 Tokyo (JP).

(72) 発明者: 柳 生 雅 文 (YAGYU Masafumi); 〒9392792 富山県富山市婦中町笹倉635日

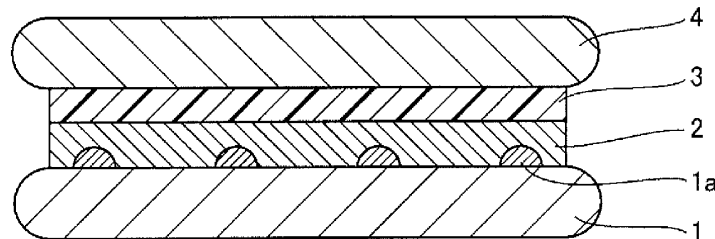
産化学株式会社材料科学研究所内 Toyama (JP). 緒方 裕斗(OGATA Hiroto); 〒9392792 富山県富山市婦中町笹倉635日産化学株式会社材料科学研究所内 Toyama (JP). 奥野 貴久(OKUNO Takahisa); 〒9392792 富山県富山市婦中町笹倉635日産化学株式会社材料科学研究所内 Toyama (JP).

(74) 代理人: 高岡 亮一, 外 (TAKAOKA Ryoichi et al.); 〒1710021 東京都豊島区西池袋5-4-7 池袋トーセイビル5階 高岡 I P特許事務所 Tokyo (JP).

(81) 指定国(表示のない限り、全ての種類の国内保護が可能): AE, AG, AL, AM, AO, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BN, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CL, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DJ, DK, DM, DO, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN, HR, HU, ID, IL, IN, IR, IS, IT, JM, JO, JP, KE, KG, KH,

(54) Title: MULTILAYER BODY, METHOD FOR PRODUCING MULTILAYER BODY, AND METHOD FOR PRODUCING SEMICONDUCTOR SUBSTRATE

(54) 発明の名称: 積層体、積層体の製造方法、及び半導体基板の製造方法



(57) Abstract: The present invention provides: a multilayer body having a bonding layer which enables easy separation of a semiconductor substrate and a supporting substrate from each other after processing of the semiconductor substrate, and which is capable of suppressing deformation of a bump; and the like. A multilayer body which is provided with: a semiconductor substrate with a bump; a supporting substrate; a bonding layer for protection, the bonding layer being formed to be in contact with the semiconductor substrate with a bump; and a bonding layer for separation, the bonding layer being formed between the bonding layer for protection and the supporting substrate. With respect to this multilayer body, the bonding layer for protection is formed from an adhesive composition for protection; the adhesive composition for protection contains a component (A) which is cured by means of a hydrosilylation reaction, but does not contain a remover agent component (B) which does not cause a curing reaction; the bonding layer for separation is formed from an adhesive composition for separation; and the adhesive composition for separation contains a component (A) which is cured by means of a hydrosilylation reaction and a remover agent component (B) which does not cause a curing reaction.

WO 2022/202029 A1

[続葉有]

KN, KP, KR, KW, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LU, LY,
MA, MD, ME, MG, MK, MN, MW, MX, MY, MZ,
NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PA, PE, PG, PH, PL, PT,
QA, RO, RS, RU, RW, SA, SC, SD, SE, SG, SK, SL,
ST, SV, SY, TH, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG,
US, UZ, VC, VN, WS, ZA, ZM, ZW.

- (84) 指定国(表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LR, LS, MW, MZ, NA, RW, SD, SL, ST, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY, KG, KZ, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, KM, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

添付公開書類:

一 国際調査報告(条約第21条(3))

(57) 要約: 半導体基板の加工後に半導体基板と支持基板とを離す際に、容易に剥離でき、かつバンプの変形を抑制できる接着層を有する積層体などの提供。バンプ付き半導体基板と、支持基板と、前記バンプ付き半導体基板に接するように形成された保護用接着層と、前記保護用接着層と前記支持基板との間に形成された剥離用接着層とを備える積層体であって、前記保護用接着層は、保護用接着剤組成物から形成され、前記保護用接着剤組成物は、ヒドロシリル化反応によって硬化する成分(A)を含み、硬化反応を起こさない剥離剤成分(B)を含まず、前記剥離用接着層は、剥離用接着剤組成物から形成され、前記剥離用接着剤組成物は、ヒドロシリル化反応によって硬化する成分(A)と、硬化反応を起こさない剥離剤成分(B)とを含む、積層体である。